Country: JP Japan

Kind

Inventor(s):FUJII GENSHIRO

Applicant(s):NEC CORP

News, Profiles, Stocks and More about this company

Issued/Filed Dates: Sept. 13, 1989 / March 10, 1988

Application Number: JP1988000000549

IPC Class: **B64G 1/50**; G05D 23/00; G05D 23/20;

Abstract: Purpose: To obtain a lighter radiator which enables automatic temperature control by means of a structure member composed of only a radiating board by closely attaching the radiating board made of a superconducting material to the member to be heat released of an artificial satellite.

Constitution: A radiating board 18 is formed with a superconducting material and is closely attached to the surface on the space 12 side of a base plate 11 so that heat is surely transmitted from the base plate 11. Hence, when the temperature of the base plate 11 rises transmitting heat to the radiating board 13, the heat radiating quantity is small until the temperature of the radiating board 13 reaches a superconduction transition temperature, while getting larger as the temperature gets higher from that temperature. As the base plate 11 is cooled by the radiating board 13, the radiating board again returns to a superconducting condition making it hard to release the heat of the base plate 11. Thereby, the temperature of the base plate 1 can be automatically controlled, realizing automatic temperature control by means of a structure member of only the radiating board 13, to obtain a lighter radiator. COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

Other Abstract Info:none

Foreign References:(No patents reference this one)

19日本国特許庁(JP)

⑪ 特 許 出 願 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-229800

@Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)9月13日

B 64 G 1/50 Ğ 05 D 23/00 23/20 ZAA

Z-8817-3D D-8835-5H

未請求 請求項の数 1 (全3頁) -8835-5H審査請求

会発明の名称

放熱器

昭63-54988 ②特 顖

政樹

昭63(1988) 3月10日 突出 題

個発 明 者 藤 井 源四郎 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

の出 顋 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

邳代 理 弁理士 山川 人

外2名

1. 発明の名称

放熟器

2 特許請求の範囲

人工衛星の被放熱部材に超電導物質からなる放 熱板を密着させたことを特徴とする放熱器。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は人工衛星等の宇宙空間で使用される機 器に使用される放敷器に関するものである。

〔従来の技術〕

人工衞星(以下単に衞風という)の風度は、衞 星の表面部材における太陽エネルギーを取り込む 度合と熱エネルギーを吐き出す度合で決まり、所 望の盆度が得られる性能を有する表面部材を選択 するととによつて調節されている。さらに、宇宙 空間において積極的に衛星の温度を調節するため には、第3図(a),(b)に示すようなサーマルルーパ が使用されている。とのサーマルルーパは衛星表 面に取付けられ、後述するプレードの開閉によつ て衛星表面から発散する輻射熱量を変化させ放熱 景を制御するもので、同図において、1は衛星の 表面部材としてのペースプレート、 2 は宇宙空間、 3はサーマルルーパで、このサーマルルーパ3は、 前記ペースプレート1に固定され、ペースプレー ト1の放熱面1aを囲むサイドフレーム3aと、 このサイドフレーム 3a 化アクチユエータ 3b を 介して回動自在に取付けられたプレード3c とか ら構成されている。また、前記アクチュエータ3b は、例えばペースプレート1の温度によつてパイ メタル(図示せず)が伸縮する動作を利用しプレ - ド3c を回動させる構造のもの等、ペースプレ ート1の温度に対応してプレード3c を回動させ る機能を備えている。すなわち、衛星の温度が上 昇すると、その熟はペースブレート1まで伝導さ れ、アクチュエータ 3b がその温度に応じてブレ ード3cを回動させるため、ペースプレート1が 宇宙空間2に露出されることになり、熱輻射によ つて放熟されることになる。なお、図中Aは輻射 熱を示す。

(発明が解決しよりとする課題)

しかるに、このように構成されたサーマルルーパ3においては、放熱量の制御をブレード3。の開閉によつて行なつているため、アクチュエータ3bの調整が複雑であつた。また、衛星に搭載される機器には、その小型化・軽量化が要求されてかり、従来のサーマルルーパ3においては、必要な放無量を得るためにはペースブレート1の放熱面1aを小さく形成するにも限度があり、このためサーマルルーパ3の各構成部材を小さく軽量に形成することができないという問題があつた。

(課題を解決するための手段)

本発明に係る放熱器は、人工衛星の被放熱部材 に超電導物質からなる放熱板を密着させたもので ある。

(作用)

超電導転移温度で輻射率が変化する超電導物質 の性質によつて、放熱板の温度が超電導転移温度 より上昇すると、熱福射量が増大し放熱量も増大 され、被放急部材の温度が低下すると、放熱板の

超電導体における赤外線輻射率 ((T)) は第2図に示すように温度でによつて定まり、特に、超電導転移温度で、付近で大きく変化する。すなわち、超電導転移温度で、より超電導体の温度が低く、超電導状態の場合には、赤外線輻射率 ((T)) は大きくなり、輻射熱量も多くなる。

したがつて、ペースプレート11の温度が上昇し、熱が放熱板13に伝導されると、放熱板13の温度が超電導転移温度で、に達するまで放熱量は少なく、Teより温度が高くなるにつれ次第に多くなる。そして、放熱板13によつてペースプレート11が冷却されると、放熱板13は再び超電球状態に戻り、ペースプレート11の熱を放熱しにくくなる。したがつて、ペースプレート11の温度が自動的に制御されることになる。

(発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、人工衛星の被放熱部材に超電導物質からなる放熱板を密着

熱輻射動も低放されることになる。

〔突流列〕

以下、その構成等を図に示す異施例により詳細に説明する。

第1図は本発明に係る放熱器を示す側断面図、 第2図は超電導体における赤外線輻射率の温度依存性を示すグラフである。これらの図において11 は人工衛星等の被放熱部材としてのペースブレート、12は宇宙空間、13は前記ペースブレート 11の温度を制御するための放熱板で、この放熱板でよって形成されてかり、前記ペースブレート11の宇宙空間12側表面に、ペースブレート11の宇宙空間12側表面に、ペースプレート11から確実に熱が伝導されるように密着されている。なお図中Aは輻射熱を示す。一般に放熱器の放熱特性は、放熱量をQ、赤外線輻射率を«、温度をTとすると

Q c t T

で設わされ、赤外線輻射率。を変化させることに よつて放熱量Qを制御することができる。また、

させたため、被放熱板から伝導された熱によつて 放熱板の温度が超電導転移温度より上昇すると、 熱温射量が増大し放熱債も増大され、被放熱部材 の温度が低下すると放熱板の熱輻射量も低減され ることになるから、被放熱部材の温度を自動的に 制御することができる。したがつて、放熱板のみ の構成部材で自動温度制御が災現されるので、軽 番化された放熱器を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る放熟器を示す側断面図、 第2図は超覚導体における赤外線輻射率の温度依存性を示すグラフ、第3図(a),(b)は従来のサーマルルーパを示す図で、同図(a)は斜視図、(b)は側断面図である。

1 1 · · · · ペースブレート、1 3 · · · · · 広 熱板。

> 特許出額人 日本電気株式会社 代理人 山川 政樹(PEか2名)

